

Características de un módulo FV

Fabricante, modelo : **Isofoton, I_110**

Disponibilidad : Prod. desde 2000 a 2005

Origen de datos : Manufacturer

Potencia STC (fabricante)	Pnom	110 Wp	Tecnología	Si-mono
Dimensiones módulo (LxA)	0.651 x 1.310	m ²	Superficie bruta módulo	Smódulo 0.85 m ²
Cantidad de células	2 x 36		Sup. sensible	Scélulas N/A m ²
Especificaciones para el modelo (fabricante o datos de medida)				
Temperatura de referencia	TRef	25 °C	Irradiancia de referencia	GRef 1000 W/m ²
Voltaje de circuito abierto	Voc	21.6 V	Corriente de cortocircuito	Isc 6.76 A
Voltaje punto potencia máx	Vmpp	17.4 V	Corriente punto potencia máx	Impp 6.32 A
=> potencia máxima	Pmpp	110.0 W	Coef. de temp. Isc	milsc 2.3 mA/°C
Parámetros de modelo con un diodo				
Resistencia paral.	Rparal	200 ohm	Corriente saturación diodo	IoRef 0.233 nA
Resistencia serie	Rserie	0.25 ohm	Coef. de temp. Voc	MuVoc -71 mV/°C
			Factor de calidad diodo	Gamma 0.97
Parámetros de Polarización Inversa, para comportamientos en sombreado parcial o desajuste				
Características inversas (oscuro)	BRev	3.20 mA/V ²	(Factor cuadrático por célula)	
Cant. diodos bypass por módulo		1	Voltaje directo diodos by-pass	-0.7 V

Resultados modelo para las condiciones estándar (STC: T=25°C, G=1000 W/m², AM=1.5)				
Voltaje punto potencia máx	Vmpp	17.4 V	Corriente punto potencia máx	Impp 6.33 A
Potencia máxima	Pmpp	110.0 Wc	Coef. de temp. potencia	miPmpp -0.42 %/°C
Eficiencia(/ Sup. módulo)	Efic_mód	12.9 %	Factor de forma	FF 0.753
Eficiencia(/ Sup. células)	Efic_cél	N/A %		

Módulo FV: Isofoton, I_110

